

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	23 W (pat) 13/04
Entscheidungsdatum:	15. November 2007
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 308 Abs. 1 Satz 1 ZPO

Durchbruchsspannung

Der auf einzelne Patentansprüche beschränkte und insoweit erfolgreiche Einspruch muss im Einspruchsverfahren zum vollen Widerruf des Patents führen, wenn der Antrag der Patentinhaberin ausschließlich auf die volle Aufrechterhaltung des Patents gerichtet ist.

Dies verstößt nicht gegen den Grundsatz der Antragsbindung (so könnte allerdings die zur Veröffentlichung vorgesehene Entscheidung 7 W (pat) 61/04 des Bundespatentgerichts vom 2. Mai 2007 missverstanden werden), weil eine Bindung nicht nur in Bezug auf den Antrag der Einsprechenden, sondern auch in Bezug auf den Antrag der Patentinhaberin besteht. Ebenso wie im Erteilungsverfahren darf auch im Einspruchsverfahren ohne entsprechenden Antrag bzw. Hilfsantrag der Patentinhaberin das Patent nicht in beschränktem Umfang aufrechterhalten bleiben.

Soweit sich aus dem Vortrag der Patentinhaberin keine Anhaltspunkte dahingehend ergeben, dass sie an einer beschränkten Aufrechterhaltung des Patents Interesse hat, besteht im Einspruchsverfahren weder für das Patentamt noch für das Bundespatentgericht Anlass auf entsprechende Anträge bzw. Hilfsanträge hinzuwirken.



BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 13/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
15. November 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 196 51 108

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. November 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Tauchert sowie der Richter Knoll, Lokys und Maile

beschlossen:

1. Der Beschluss der Patentabteilung 1.33 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. November 2003 wird aufgehoben und das Patent wird aufrechterhalten.
2. Der Antrag der Patentinhaberin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Auf die am 9. Dezember 1996 eingegangene Patentanmeldung, für die die Priorität der Anmeldung in Japan vom 11. April 1996 (*Aktenzeichen JP 08-089439*) in Anspruch genommen ist, hat die Prüfungsstelle für Klasse H 01 L des Deutschen Patent- und Markenamts das nachgesuchte Patent 196 51 108 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Halbleitereinrichtung des Grabentyps mit hoher Durchbruchspannung und ihr Herstellungsverfahren“ erteilt. Das am 23. November 2000 veröffentlichte Patent enthält je drei nebengeordnete Vorrichtungs- und Verfahrensansprüche.

Nach Prüfung eines für zulässig erklärten Einspruchs hat die Patentabteilung 1.33 des Deutschen Patent- und Markenamts das Streitpatent mit Beschluss vom 25. November 2003 in vollem Umfang widerrufen.

In den Beschlussgründen ist ausgeführt, dass die Halbleitereinrichtung mit hoher Durchbruchspannung nach dem erteilten Anspruch 1 gegenüber dem Offenbarungsgehalt der auf einer älteren Anmeldung beruhenden nachveröffentlichten deutschen Offenlegungsschrift DE 195 22 161 A1 (Druckschrift D4) nicht neu sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin.

Die im Verfahren eingeführten Druckschriften sind:

- Matsushita et al., „Blocking Voltage Design Consideration for Deep Trench MOS Gate High Power Devices“ in Proc., ISPSD 95, Seiten 256 bis 261
(Druckschrift D1)
- Kitagawa et al., „4500V IEGTs having Switching Characteristics Superior to GTO“ in Proc., ISPSD 95, Seiten 486 bis 491
(Druckschrift D2)
- JP 07-050405 A
(Druckschrift D3)
- DE 195 22 161 A1
(Druckschrift D4)
- US 5 448 083
(Druckschrift D5)
- EP 668 616 A2
(Druckschrift D6)
- EP 527 600 A1
(Druckschrift D7)
- Stengl/Tihanyi: „Leistungs-MOS-FET-Praxis“, Pflaum-Verlag; München 1992
Seiten 33 bis 36 sowie Seite 106
(Druckschrift D8)

und

- B. J. Baliga: „Modern Power Devices“, Krieger Publishing Company, 1992
Malabar, Florida, USA, Seiten 352 und 353 sowie Seite 439

(Druckschrift D9)

In der mündlichen Verhandlung vom 15. November 2007 trägt der Vertreter der Patentinhaberin sinngemäß vor, dass der im Verfahren befindliche Stand der Technik dem Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 nicht patenthindernd entgegenstehe; insbesondere sei dieser neu gegenüber der Druckschrift D4.

Die Patentinhaberin beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 1.33 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. November 2003 aufzuheben und das Patent aufrechtzuerhalten.

Außerdem beantragt sie,

die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Die Einsprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Vertreter der Einsprechenden macht hierzu in der Verhandlung geltend, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 unter Berücksichtigung des fachmännischen Wissens vollständig aus der Druckschrift D4 zu entnehmen sei und die beanspruchte Halbleitereinrichtung mit hoher Durchbruchspannung daher nicht neu und somit nicht patentfähig sei.

Der geltende, mit Gliederungspunkten versehene Patentanspruch 1 lautet:

- a)** „Halbleitereinrichtung mit hoher Durchbruchsspannung mit:
- b)** einem Halbleitersubstrat (1) eines ersten Leitungstyps mit einer ersten und einer zweiten Hauptoberfläche,
- c)** einer auf der ersten Hauptoberfläche gebildeten ersten Dotierungsschicht (4) eines zweiten Leitungstyps,
- d)** Gategräben (70), die mit einem vorbestimmten Abstand voneinander angeordnet sind,
- e)** und von denen jeder eine Ausnehmung (7a),
- f)** die sich von der ersten Dotierungsschicht (4) in das Halbleitersubstrat (1) erstreckt,
- g)** einen Gateisolierfilm (7),
- h)** der eine innere Oberfläche der Ausnehmung (7a) bedeckt, und
- i)** eine Gateelektrode (8), die die Ausnehmung (7a) füllt und die aus einem elektrischen Leiter gebildet ist, aufweist,
- j)** einem Paar von Dotierungsbereichen (5) des ersten Leitungstyps, die nahe einer Oberfläche der ersten Dotierungsschicht (4) gebildet sind und die an gegenüberliegenden Seiten eines Gategrabens (70) angeordnet sind,
- k)** einer über der ersten Hauptoberfläche gebildeten ersten Hauptelektrodenschicht (10),
- l)** die gegenüber den Gategräben (70) mit einem Isolierfilm (19) dazwischen vorgesehen ist
- m)** und die elektrisch mit den Dotierungsbereichen (5) und der ersten Dotierschicht (4) verbunden ist,
- n)** einer auf der zweiten Hauptoberfläche gebildeten zweiten Dotierungsschicht (3) des zweiten Leitungstyps und
- o)** einer auf einer Oberfläche der zweiten Dotierungsschicht (3) gebildeten zweiten Hauptelektrodenschicht (11), und

- q) einer Isolierschicht (15), die an einer Position in dem Halbleitersubstrat (11)
- p) zwischen den Gategräben (70) angeordnet ist.“

Wegen der geltenden erteilten selbstständigen Ansprüche 2 bis 6; welche im Verlauf des Verfahrens nicht angegriffen wurden, wird auf die Streitpatentschrift und wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die zulässige Beschwerde der Patentinhaberin hat nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung zwar insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Aufrechterhaltung des Patents, nicht jedoch zur Rückzahlung der Beschwerdegebühr führt.

1.) Die Zulässigkeit des Einspruchs ist auch im Beschwerdeverfahren von Amts wegen zu überprüfen (vgl. *BGH BIPMZ 1972, 173, Leitsatz b*) - „Sortiergerät“). Im vorliegenden Fall bestehen gegen die Zulässigkeit des Einspruchs seitens des Senats insofern keine Bedenken, als die Einsprechende innerhalb der Einspruchsfrist den Widerrufgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht und dazu der erforderlichen Zusammenhang zwischen sämtlichen Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1 des Streitpatents sowie dem Stand der Technik nach Druckschrift D4 unter Einbeziehung des fachmännischen Wissens und Könnens hergestellt, d. h. die Tatsachen im einzelnen angegeben hat, aus denen sich ergeben soll, dass das Patent zu widerrufen ist (vgl. hierzu *BGH BIPMZ 1988, 250, Leitsatz, 251, li. Sp., Abs. 1- „Epoxidation“*; *Schulte, PatG, 7. Auflage, § 59 Rdn. 77 bis 82 und 90*).

Die Zulässigkeit des Einspruchs ist von der Patentinhaberin im Übrigen auch nicht bestritten worden.

2.) Gegen die Zulässigkeit der geltenden Patentansprüche 1 bis 6 des Streitpatents bestehen insofern keine Bedenken, als sich diese von den ursprünglichen Patentansprüchen lediglich durch - ursprünglich offenbarte - klarstellende Änderungen und die Berichtigung offensichtlicher Fehler unterscheiden.

3.) Das Streitpatent geht von einer bekannten - druckschriftlich nicht belegten - Halbleitereinrichtung mit hoher Durchbruchsspannung gemäß Fig. 49 mit zugehöriger Beschreibung (*vgl. hierzu Spalte 1, 3. Absatz bis Spalte 2, 1. Absatz*) aus. Diese Halbleitereinrichtung unterscheidet sich von der nunmehr im Anspruch 1 beanspruchten durch das Fehlen der Isolierschicht (15). Bei der aus Fig. 49 bekannten Vorrichtung sei beim Ausschalten der Halbleitereinrichtung mit stoßerzeugten Ladungsträgern zu rechnen, was das Ausschalten der Halbleitereinrichtung verzögere (*vgl. Beschreibung Spalte 4, Zeile 49 bis Spalte 5, Zeile 23*).

Darüber hinaus bestehe der Wunsch, dass zur Erhöhung der im Kanal fließenden Elektronen, der Löcherstrom in die erste Dotierungsschicht 4 zu reduzieren sei. Im Streitpatent werden hierzu Maßnahmen aus dem Stand der Technik angegeben (Druckschriften 1 bis 3). Alle hier vorgeschlagenen Maßnahmen hätten jedoch den Nachteil, dass bei ihnen entweder die Gatekapazität ansteige bzw. sich die Durchbruchsspannung erniedrige.

Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatentgegenstand als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, eine Halbleitereinrichtung des Gategrabentyps mit einer hohen Durchbruchsspannung zur Verfügung zu stellen, die eine hohe Durchbruchsspannung erreichen kann, ohne eine Gatekapazität in einem AUS-Zustand der Einrichtung zu erhöhen, deren Sättigungsspannung reduziert werden kann, ohne die Durchbruchsspannung im AUS-Zustand zu reduzieren und deren Ausschaltverlust reduziert ist. (*vgl. Streitpatentschrift, Spalte 5, Zeile 33 ff.*)

Diese Aufgabe wird mit der Halbleitereinrichtung mit hoher Durchbruchsspannung nach den Merkmalen des Anspruchs 1 des Streitpatents gelöst.

Das Vorsehen einer Isolierschicht (15) an Positionen in dem Halbleitersubstrat (1) zwischen den Gategräben (70) ermögliche es, gleichzeitig alle drei in der Aufgabenstellung genannte Bauelementkenngößen so zu optimieren, dass die jeweils anderen Größen nicht negativ beeinflusst werden. (vgl. Ausführungen Streitpatent Spalte 5, Zeile 50 bis Spalte 6, Zeile 5 und Spalte 15, Zeile 47 bis Spalte 16, Zeile 26 sowie Spalte 6, Zeilen 6 bis 20 und Spalte 16, Zeilen 27 bis 46 sowie Spalte 6, Zeile 33 bis Spalte 7, Zeile 2 sowie Spalte 17, Zeilen 13 bis 42).

4.) Der hier zuständige Fachmann ist ein mit der Entwicklung von Leistungs-Halbleitereinrichtungen befasster, berufserfahrener Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik oder ein Diplom-Physiker jeweils mit Hochschulausbildung.

5.) Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ist neu hinsichtlich des Offenbarungsgehalts der nachveröffentlichten Druckschrift D4, denn die **Merkmale f) und q)** sind nach Überzeugung des Senats vom Fachmann aus der Druckschrift D4 weder direkt noch indirekt zu entnehmen.

Druckschrift D4 lehrt (vgl. Fig. 2), dass die vorzusehenden Gategräben der dort beanspruchten Halbleitereinrichtung an der Grenzfläche zwischen der ersten Dotierungsschicht des zweiten Leitungstyps und dem Halbleitersubstrat *enden*. Eine schaltfähige IGBT-Halbleitereinrichtung ist durch diese Anordnung zweifelsfrei und unbestritten hergestellt. Weitere Hinweise zur Ausgestaltung des Grabens, insbesondere zu einer Erstreckung des Grabens in das Halbleitersubstrat - wie im **Merkmal f)** beansprucht - sind der Druckschrift D4 nicht zu entnehmen.

Druckschrift D4 lehrt ferner (vgl. Fig. 2 mit zugehöriger Beschreibung), dass die Isolierschicht *zwischen* der ersten Dotierungsschicht und dem Halbleitersubstrat liegt (vgl. hierzu Spalte 2, Zeilen 33 und 34). Einen Hinweis die erste Dotierungsschicht an einer Position *in* dem Halbleitersubstrat - wie im **Merkmal q)** beansprucht - vorzusehen, kann der DruckschriftD4 ebenfalls nicht entnommen werden.

Der Argumentation der Einsprechenden, wonach das **Merkmal f)**, aufgrund eines zur Herstellung der Gategräben verwendeten Ätzverfahrens bzw. des schaltungstechnischen Hintergrunds der Halbleitereinrichtung, in Druckschrift D4 vom Fachmann mitgelesen wird, kann vom Senat nicht gefolgt werden:

Neben dem von der Einsprechenden zur Argumentation angeführten Ätzverfahren existieren unstrittig noch weitere Verfahren zur Erzeugung der Gategräben, beispielsweise die Grabenerzeugung bei einer epitaktischen Abscheidung der ersten Dotierungsschicht.

Entgegen den Ausführungen der Einsprechenden vermögen zufällige Variationen der Äztiefe der Gategräben nicht den Fachmann dazu anzuregen, das Bauelement *gezielt* so auszugestalten, dass die Gategräben bis in das Halbleitersubstrat *zwingend* hineinreichen. Insofern ist die Argumentation auch nicht geeignet, ein Naheliegen des iRs Merkmals zu begründen.

Dem Argument der Einsprechenden hinsichtlich des **Merkmals q)**, wonach bei Verwendung eines Implantationsverfahrens die iRs Isolierschicht *in* dem Halbleitersubstrat ausgebildet wird, vermag der Senat ebenfalls nicht folgen, denn in der Druckschrift D4 ist nicht offenbart, die Isolierschicht *durch* sondern *beispielsweise bei* einer Implantation herzustellen ist (*vgl. hierzu Spalte 2, Zeilen 43 bis 45*). Hieraus in Zusammenschau mit der Fig. 2 abzuleiten, die Isolierschicht läge *zwingend* in dem Halbleitersubstrat, ist jedoch für den Fachmann nicht möglich, ohne dass dieser hierbei selbst erfinderisch tätig werden müsste.

Vielmehr wird er die Anregung der Druckschrift D4 aufgreifen, und die Isolierschicht wie dort beschrieben - abweichend von dem im Streitpatent Beanspruchten - genau zwischen den entsprechenden Schichten anordnen.

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist somit aus der nicht vorveröffentlichten und somit nur im Rahmen der Neuheitsprüfung heranzuziehenden Druckschrift D4 vom eingangs zugrunde gelegten Fachmann nicht zu entnehmen.

Die weiteren im Verfahren genannten Druckschriften sind nicht geeignet, die Patentfähigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 in Abrede zu stellen, da sie ersichtlich das Vorsehen einer Isolierschicht in dem Halbleitersubstrat bzw. zwischen dem Halbleitersubstrat und der ersten Dotierungsschicht weder lehren, noch dazu eine Anregung geben.

Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 hat somit Bestand.

6.) Auch die Gegenstände der nebengeordneten Ansprüche 2 bis 6 werden durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik ersichtlich weder einzeln noch in Kombination vorweggenommen oder durch diesen nahegelegt. Die nebengeordneten Ansprüche 2 bis 6 haben daher ebenfalls Bestand.

III

Der Antrag der Inhaberin des angegriffenen Patents auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr war zurückzuweisen. Nach § 80 Abs. 3 PatG kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Dies kann bei Verfahrensfehlern oder auch nur unsachgemäßer Sachbehandlung der Fall sein (vgl. Schulte, PatG, 7. Aufl., § 80 Rdn. 66 ff.; Busse, PatG, 6. Aufl., § 80 Rdn. 95 m. w. N.).

Eine fehlerhafte oder unsachgemäße, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigende Verfahrensweise kann der Patentabteilung indes nicht vorgeworfen werden. Insbesondere kann eine solche Verfahrensweise entgegen der von der Inhaberin des angegriffenen Patents in der mündlichen Verhandlung geäußerten Auffassung auch nicht darin gesehen werden, dass die Patentabteilung dem in der Einspruchserwiderung vom 18. Juli 2001 hilfsweise gestellten Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung nicht stattgegeben hat, sondern ohne Anhörung in der Sache entschieden hat. Die Verweigerung eines beantragten Anhörungstermins stellt nicht schon für sich genommen einen Verfahrensfehler

dar. Eine Anhörung sollte nach der bis 30. Juni 2006 geltenden und für die vorliegend angefochtene Entscheidung von November 2003 maßgeblichen Rechtslage nur dann auf Antrag stattfinden, wenn sie sachdienlich war, § 59 Abs. 3 i. V. m. § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG, wobei die Patentabteilung insoweit einen Beurteilungsspielraum hatte (vgl. Busse, 6. Aufl., § 46 Rdn. 13). Anders als im Anmelderbeschwerdeverfahren ist nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts die Durchführung einer Anhörung nach der bis 30. Juni 2006 geltenden Rechtslage im Einspruchsverfahren nicht als in der Regel sachdienlich angesehen worden (vgl. dazu Busse, 6. Aufl., § 59 Rdn. 178; vgl. auch BPatGE 39, 204). Die Rechtslage zur Notwendigkeit einer Anhörung hat sich erst durch das Gesetz zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes vom 21. Juni 2006 (BGBl I Seite, 1318) mit Wirkung zum 1. Juli 2006 geändert, weil nunmehr gemäß § 61 Abs. 3 PatG eine Anhörung stattfinden muss, wenn ein Beteiligter sie beantragt.

Im vorliegenden Einspruchsverfahren waren die Gesichtspunkte zur Patentfähigkeit des angegriffenen Patents zwischen den Beteiligten schriftsätzlich diskutiert worden, wobei jede Beteiligte zwei Schriftsätze eingereicht hat und zu den jeweils von der Gegenseite aufgeworfenen Fragen Stellung nehmen konnte. Bei dieser Sachlage durfte die Patentabteilung davon ausgehen, dass die Standpunkte ausdiskutiert sind und durch eine mündliche Verhandlung keine wesentlich neuen Erkenntnisse gewonnen werden. Jedenfalls kann die Vorgehensweise der Patentabteilung, nunmehr ohne Anhörung zu entscheiden unter dem Kostengesichtspunkt des § 80 Abs. 3 PatG nicht als fehlerhaft angesehen werden.

Es war auch nicht verfahrensfehlerhaft, dass die Patentabteilung das Patent in vollem Umfang widerrufen hat, obwohl die Einsprechende mit ihrem Einspruch nur den Patentanspruch 1 angegriffen hat. Dies verstößt entgegen der von der Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung geäußerten Auffassung nicht gegen den Antragsgrundsatz. Die Patentabteilung darf zwar nach dem Antragsgrundsatz das Patent grundsätzlich nur insoweit widerrufen als es angefochten ist (so klarstellend

die jüngste Rechtsprechung des BGH GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II, in der zu dieser Frage die Rechtsprechung des BGH, GRUR 1997, 120 - elektrisches Speicherheizgerät - fortgeführt und weiterentwickelt wird; differenzierend zu diesem Problem der Antragsbindung beim Einsprechenden die bisherige Rechtsprechung des Bundespatentgerichts vgl. dazu Busse, 6. Aufl., § 59 Rdn. 160 mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen, insbesondere die sich widersprechenden Entscheidungen BPatG GRUR 2002, 55 und BPatGE 42, 84). Der Antragsgrundsatz gilt aber nicht nur für den Antrag der Einsprechenden, sondern auch für den Antrag der Patentinhaberin (vgl. Schulte, PatG, 7. Aufl., § 59 Rdn. 174; Busse, PatG, 6. Aufl., § 59 Rdn. 156-159 m. w. N.; siehe dazu auch - Informationsübermittlungsverfahren II a. a. O.). Die Patentinhaberin hatte beantragt, dass Patent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten, ohne dass sie etwa hilfsweise auch die Aufrechterhaltung des Patents ohne den angegriffenen Patentanspruchs 1 beantragt hat. Aufgrund dieses Antrags war die Patentabteilung gehindert, das Patent teilweise und damit in einer vom Antrag der Patentinhaberin abweichenden Form aufrechtzuerhalten (vgl. dazu Schulte und Busse a. a. O.). Vielmehr fiel aufgrund der Bindung an diesen Antrag vom Standpunkt der Patentabteilung zur fehlenden Patentfähigkeit des Patentanspruchs 1 folgerichtig mit diesem Patentanspruch das Patent insgesamt.

Auch unter dem Gesichtspunkt, im Rahmen der Verfahrensführung auf sachdienliche Anträge hinzuwirken, bestand für die Patentabteilung keine Veranlassung auf einen entsprechenden Hilfsantrag hinzuwirken und deshalb einen Hinweis zu geben oder gar einen Anhörungstermin anzuberaumen. Entgegen der in der mündlichen Verhandlung geäußerten Auffassung konnte die Patentinhaberin durch den vollen Widerruf des Patents nicht überrascht sein. Aufgrund der Angriffe der Einsprechenden gegen den Patentanspruch 1 und aufgrund ihres eigenen Antrags auf Aufrechterhaltung des Patents in dem erteilten Umfang musste sie damit rechnen, dass das Patent in vollem Umfang widerrufen wird, wenn die Patentabteilung zur Frage der Patentfähigkeit des Patentanspruchs 1 der Auffassung der Einsprechenden folgt. Der Grundsatz der Antragsbindung auch an den Antrag der Patent-

inhaberin gehört im Einspruchsverfahren zum verfahrensrechtlichen Basiswissen und steht in der patentrechtlichen Literatur und Rechtsprechung außerhalb jeder Diskussion, vgl. die oben genannten Fundstellen. Die Patentinhaberin war anwaltschaftlich vertreten und für die Patentabteilung bestand keine Veranlassung, sie vor einer Entscheidung auf die ohne weiteres vorhersehbaren möglichen Folgen ihrer Antragstellung hinzuweisen. Aus den Schriftsätzen der Patentinhaberin ergeben sich im Übrigen keine Anhaltspunkte dahingehend, dass sie Interesse auch an der beschränkten Aufrechterhaltung ihres Patent hatte, was dann für die Patentabteilung Anlass geboten hätte, einen Hinweis zu geben bzw. auf einen entsprechenden Hilfsantrag hinzuwirken.

Unter dem Aspekt einer Rückerstattung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen war die Verfahrensweise der Patentabteilung somit nicht zu beanstanden, so dass dem Antrag der Patentinhaberin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht entsprochen werden konnte.

Dr. Tauchert

Knoll

Lokys

Maile

Be